

Title	一次元準結晶の電子状態とLie代数(クエイサイクリスタルの構造と物性, 科研費研究会報告)
Author(s)	大沢, 一人
Citation	物性研究 (1987), 48(2): A47-A49
Issue Date	1987-05-20
URL	http://hdl.handle.net/2433/92501
Right	
Type	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

一次元準結晶のモデルはフィボナッチの 0、1 列である。1 を井戸、0 を壁に置き換えたようなポテンシャルを想定しこれをフィボナッチ系と呼ぶことにする。図 1。私はこのようなポテンシャル中の電子のバンド構造を研究した。

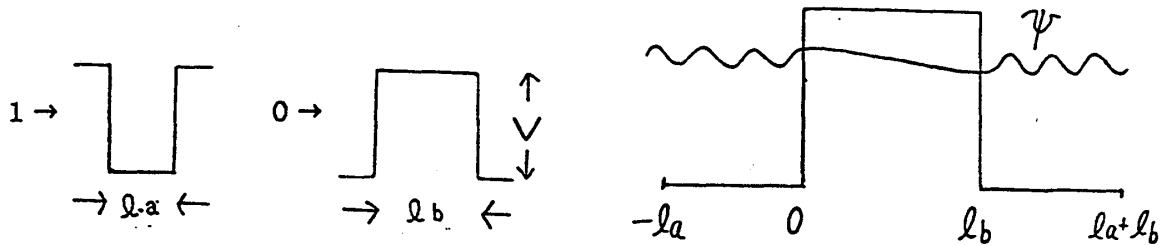


図 1

一次元系を調べる有力な方法は伝送行列の方法である。例として壁に対応する伝送行列をつくってみよう。Schrödinger 方程式を

$$(-\nabla^2 + v(x)) \Psi(x) = E \Psi(x) \quad \text{但し } v(x) = \begin{cases} V & \text{壁} \\ 0 & \text{井戸} \end{cases}$$

一次元では波動関数は独立な 2 つの固有関数の一次結合である。E < V の時は

$$[-l_a, 0] \quad \Psi(x) = a_1 \cos(kx) + b_1 \sin(kx)$$

$$[0, l_b] \quad \Psi(x) = a_2 \exp(\epsilon x) + b_2 \exp(-\epsilon x)$$

$$[l_b, l_a + l_b] \quad \Psi(x) = a_3 \cos(kx) + b_3 \sin(kx)$$

$$\text{但し } k \equiv \sqrt{E} \quad \epsilon \equiv \sqrt{V - E}$$

$\Psi(x)$ と $\nabla \Psi(x)$ は連続だから $x=0$ 、 $x=l_b$ で a 、 b には次のような関係がある。

$$x=0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \epsilon & -\epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$x=l_b$$

$$\begin{pmatrix} \cos(k l_b) & \sin(k l_b) \\ -k \sin(k l_b) & k \cos(k l_b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \exp(\epsilon l_b) & \exp(-\epsilon l_b) \\ \epsilon \exp(\epsilon l_b) & -\epsilon \exp(-\epsilon l_b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}$ を消去すると壁 1 つに対応する伝送行列を得る。これを B とする。

$$B \equiv \begin{pmatrix} \cosh(\epsilon l_b) & \sinh(\epsilon l_b) / \epsilon \\ \epsilon \sinh(\epsilon l_b) & \cosh(\epsilon l_b) \end{pmatrix}$$

$E > V$ の時は $\varepsilon \equiv \sqrt{E-V}$ として壁に対する伝送行列は

$$B \equiv \begin{pmatrix} \cos(\varepsilon \varrho_b) & \sin(\varepsilon \varrho_b) / \varepsilon \\ -\varepsilon \sin(\varepsilon \varrho_b) & \cos(\varepsilon \varrho_b) \end{pmatrix}$$

である。まったく同様に井戸に対する伝送行列も得られそれを A とする。

$$A \equiv \begin{pmatrix} \cos(k \varrho_a) & \sin(k \varrho_a) / k \\ -k \sin(k \varrho_a) & \cos(k \varrho_a) \end{pmatrix}$$

伝送行列 A B は n_a 、 n_b を任意な整数とすると次のようにかける。

$$A = (-1)^{n_a} \exp\left(\frac{\sqrt{E} \varrho_a - n_a \pi}{\sqrt{E}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -E & 0 \end{pmatrix}\right) \quad B = (-1)^{n_b} \exp\left(\frac{\sqrt{E-V} \varrho_b - n_b \pi}{\sqrt{E-V}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ V-E & 0 \end{pmatrix}\right)$$

$M = \exp(X)$ の時 M を $Li e$ 群、 X を $Li e$ 環という。 n_a 、 n_b を自由にとれるから $Li e$ 環は多くの表し方がある。これを $Li e$ 環の多価性と呼ぶことにする。そこで

$$\alpha = \frac{\sqrt{E} \varrho_a - n_a \pi}{\sqrt{E}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -E & 0 \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{\sqrt{E-V} \varrho_b - n_b \pi}{\sqrt{E-V}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ V-E & 0 \end{pmatrix}$$

とおいてこれからは伝送行列 e^α e^β を使いバンド構造を説明する。ハウドルフの公式を何度も使い

$$\begin{aligned} M &= A B A A B A B A \dots \\ &= e^\alpha e^\beta e^\alpha e^\alpha e^\beta e^\alpha e^\beta e^\alpha \dots \\ &= e^\gamma \end{aligned}$$

として γ が得られたとする。 $|\text{Tr}(M)| \leq 2$ の時固有エネルギーをもつことができる。ところで $\det(M) = 1$ だから $|\text{Tr}(M)| \leq 2$ と $\det(\gamma) \geq 0$ は同値である。そこで $\det(\gamma) \geq 0$ は固有エネルギーをもつかどうかの判別式になる。 n 世代のフィボナッチ系の伝送行列を M_n 、 n 番目のフィボナッチ数を f_n 、高次の交換項を O_n とする。リカーゾン公式より

$$\begin{aligned} M_{n+2} &= M_{n+1} M_n \\ &= \exp(f_n \alpha + f_{n-1} \beta + O_{n+1}) \exp(f_{n-1} \alpha + f_{n-2} \beta + O_n) \\ &= \exp\left\{ (f_n + f_{n-1}) \alpha + (f_{n-1} + f_{n-2}) \beta \right. \\ &\quad \left. + 1/2 (f_n f_{n-2} - f_{n-1}^2) [\alpha, \beta] + O_{n+2} \right\} \end{aligned}$$

$f_n f_{n-2} - f_{n-1}^2 = (-1)^{n-1}$ である。だから γ の高次の交換項は小さいと仮定する。

$$\therefore \gamma \propto \frac{\sqrt{5}+1}{2} \alpha + \beta$$

$n=0$ を代入し $\det(\gamma) \geq 0$ よりフィボナッチ系の最低固有値がわかる。

$$E \geq \frac{\varrho_b V}{\frac{\sqrt{5}+1}{2} \varrho_a + \varrho_b}$$

$Q_a = Q_b$ という井戸と壁の長さが等しい時のバンド構造は図2であり最低固有値は

$$E \geq \frac{2}{\sqrt{5+3}} V \approx 0.382 V$$

Li e環の多価性のためある程度バンドギャップも説明できる。最低固有値の時と同様高次の交換項を無視することにする。 $Q_a = Q_b = 1$ の時は $n_a = n_b = n$ とすると $E = (n\pi)^2$ 付近のバンドギャップを説明できる。バンドギャップとは2本の曲線にはさまれた領域である。 $\det(\gamma) = 0$ となるのは

$$\frac{\sqrt{5+1}}{2} \frac{\sqrt{E-n\pi}}{\sqrt{E}} + \frac{\sqrt{E-V-n\pi}}{\sqrt{E-V}} = 0 \quad \text{---(1)}$$

$$\frac{\sqrt{5+1}}{2} \sqrt{E}(\sqrt{E-n\pi}) + \sqrt{E-V}(\sqrt{E-V-n\pi}) = 0 \quad \text{---(2)}$$

の2式のどちらかが成り立つところであるがこの2式は $E = (n\pi)^2$ 付近のバンドエッジを表している。図3は $n=1$ の場合 $E = \pi^2$ 付近にできるギャップをみたものである。

Li e環の非交換項だけとるとという荒っぽい近似であるがバンド構造とよく一致している。これはフィボナッチ系の特徴である。

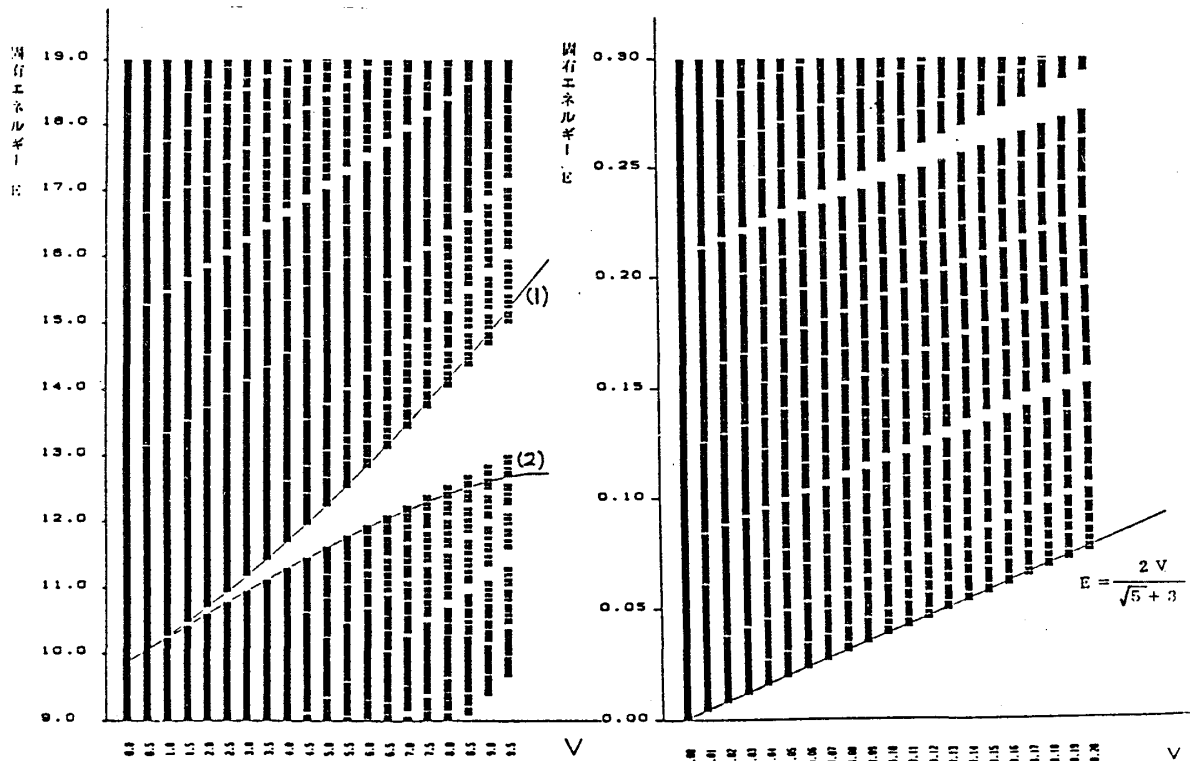


図3

図2